

Silicon Diode

BAY52

15V / 100mA

DATASHEET

OEM – SEL

Source: SEL Databook 1965



Silizium-Planar-Diode

BAY 52**Ausführung**

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode, Kathode durch roten Farbpunkt gekennzeichnet.

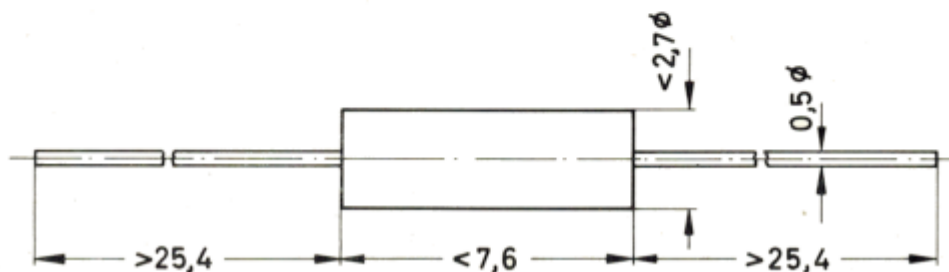
Verwendung

Diode für schnelle Schalter in der kommerziellen Technik.

Abmessungen

(Maße in mm)

Gehäuse DO-7

**Grenzdaten**

Verlustleistung	$T_u = 25\text{ °C}$	P	200	mW
	$T_u = 45\text{ °C}$		170	mW
	$T_u = 100\text{ °C}$		100	mW
Sperrspannung	$T_u = 25\text{ °C}$	U_R	15	V
Durchlaßgleichstrom		I_F	100	mA
Durchlaßspitzenstrom		i_{FM}	200	mA
Maximale Lagertemperatur		$+T_s$	150	°C
Minimale Lagertemperatur		$-T_s$	55	°C
Maximale Sperrschichttemperatur		$+T_j$	165	°C
Minimale Sperrschichttemperatur		$-T_j$	55	°C

BAY 52**Statische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$**

Sperrstrom	$U_R = 10\text{ V}$	I_R	≤ 50	nA
Durchlaßstrom	$U_F = 1\text{ V}$	I_F	≥ 20	mA

Dynamische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$

Diodenkapazität	$U_R = 0,5\text{ V}$	C	≤ 8	pF
Sperrverzögerungszeit	von $I_F = 10\text{ mA}$ bei $R_L = 100\text{ }\Omega$	auf $U_R = 6\text{ V}$ t_{rr}	≤ 15	ns

